

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 10-300428

(43) Date of publication of application : 13.11.1998

(51) Int.Cl. G01B 11/02
G03F 7/26
H01L 21/027

(21) Application number : 10-040603
(22) Date of filing : 23.02.1998

(71) Applicant : TOSHIBA CORP

(72) Inventor : HAYAZAKI KEI
ITO SHINICHI
KAWANO KENJI
INOUE SOICHI
OKUMURA KATSUYA

(30) Priority

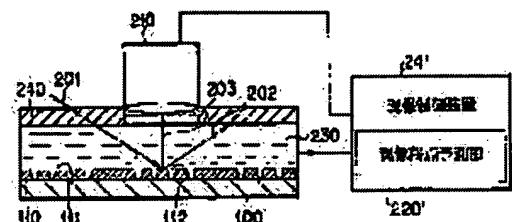
Priority number : 09 42245 Priority date : 26.02.1997 Priority country : JP

(54) PATTERN DIMENSION EVALUATING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately control the dimension of resist patterns through the control of development time, even for different wafers.

SOLUTION: A resist 110 on a wafer 100 is exposed to a device pattern 111, and the device pattern 111 is formed by a predetermined time of development. In this case, during exposure of the resist 110 rectangular element patterns are periodically arranged adjacent to one another, then exposure to a monitor pattern 112 which differs in repeating pitch from the device pattern 111 is effected, and during development of the resist 110 a parallel beam 201 having a wavelength of 400 nm is applied to the monitor pattern 111; the strength of primary diffracted light 203 obtained through diffraction by the monitor pattern 111 is detected, the device pattern is evaluated on the basis of the relation between dimensions calculated in advance and the strength of the diffracted light, and development time is controlled on the basis of the evaluation result.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 10.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-300428

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

(51)Int.Cl.⁶

G 0 1 B 11/02

G 0 3 F 7/26

H 0 1 L 21/027

識別記号

5 0 1

F I

G 0 1 B 11/02

G 0 3 F 7/26

H 0 1 L 21/30

G

5 0 1

5 0 2 V

5 0 2 G

審査請求 未請求 請求項の数20 O L (全 20 頁)

(21)出願番号

特願平10-40603

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 早崎 圭

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 伊藤 信一

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 川野 健二

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

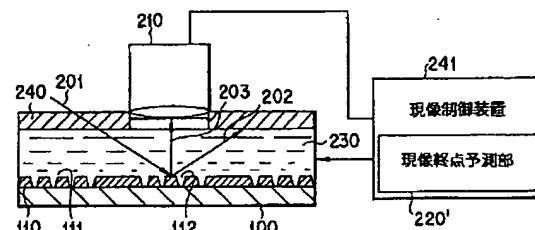
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 パターン寸法評価装置

(57)【要約】

【課題】 現像時間の制御により異なるウエハに対してレジストパターンの精密な寸法制御を可能にする。

【解決手段】 ウエハ100上のレジスト110にデバイスパターン111を露光し、所定時間の現像によりデバイスパターン111を形成するパターン形成方法において、レジスト110の露光時に、矩形状の要素パターンを隣接して周期的に配置し、その繰り返しのピッチをデバイスパターン111とは異なるモニタパターン112を露光しておき、レジスト110の現像中に、モニタパターン111に波長400nmの平行光201を照射し、モニタパターン111より回折して得られる1次回折光203の強度を検出し、求められている寸法と回折光強度との関係を基にデバイスパターンの評価を行い、この評価結果から現像の時間制御を行う。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理体上の、デバイスパターンと異なる位置に形成されたモニタ領域に対し、特定波長の平行光を照射するための照明手段と、

前記モニタ領域からの回折光強度を検出する手段と、このモニタ領域からの回折光強度に基づいて前記デバイスパターン寸法を評価するデバイスパターン評価手段とを有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項2】 請求項1のパターン寸法評価装置において、

前記被処理体のモニタ領域には、モニタパターンが設けられており、

このモニタパターンは、

デバイスパターンとは異なる要素パターンで構成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項3】 請求項2記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタパターンは、

前記デバイスパターンと異なるピッチで形成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項4】 請求項2記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタパターンは、

パターンの周期性の方向が、前記デバイスパターンと異なるように形成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項5】 請求項2記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタパターンは、

露光用パターン要素の間隔が解像限界以下となるように隣接して周期的に配置してなる露光パターンを通してレジストを露光することで形成されたものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項6】 請求項1記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタ領域は、

全体に亘って略均一の現像速度となるように露光され、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるよう形成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項7】 請求項6記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタ領域は、

デバイスパターンを作成したマスクと同一面内に作成し

たマスクパターンを用いてデバイスパターンと同一条件で露光することにより作成するものであって、モニタ領域形成用のマスクパターンは、露光条件に対して被処理体上に0次回折光しか到達しないピッチを有する規則パターンであり、かつ、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるような透過率となるようにマスクパターンの抜きと残しの比率が設計されたものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項8】 請求項1記載のパターン寸法評価装置において、

前記デバイスパターン評価手段は、前記モニタ領域からの0次回折光若しくは1次回折光の光強度に基づいてデバイスパターン寸法を評価するものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項9】 請求項8記載のパターン寸法評価装置において、

前記照明手段は、照明光をモニタ領域に対して垂直に照射する手段を有し、

前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる0次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項10】 請求項8記載のパターン寸法評価装置において、

前記照明手段は、照明光をモニタ領域に対して斜め方向から照射する手段を有し、

前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる1次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項11】 請求項8記載のパターン寸法評価装置において、

前記照明手段は、0次回折光検出用の照明光をモニタ領域に対して垂直に照射する手段と、1次回折光検出用の照明光をモニタ領域に対して斜め方向から照射する手段とを有し、

前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる0次回折光及び1次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項12】 請求項8記載のパターン寸法評価装置において、

モニタ領域からの1次回折光の検出結果とモニタ領域・デバイスパターンからの0次回折光の検出結果との論理積から、モニタ領域の位置を検出するモニタ領域検出手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項13】 請求項1記載の装置において、前記照明手段と回折光の検出手段とを保持するモニタヘッドと前記回折光の検出手段による検出に基づいてモニタ領域を検知する手段とを有し、

検知したモニタ領域に対し、このモニタヘッドを駆動・位置決めするモニタヘッド位置決め手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項14】 請求項1のパターン寸法評価装置において、

この装置は、デバイスパターンの現像終点を検出するのに適用されるものであって、

前記パターン寸法評価手段は、モニタ領域からの回折光の強度変化に基づいて現像の終点を判断する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項15】 請求項14記載のパターン寸法評価装置において、

前記現像の終点を判断する手段は、

回折光強度の時間微分値を求め、予め求められている現像時間と回折光強度の時間微分値との関係と照合することにより、現像の終点を検出するものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項16】 請求項14のパターン寸法評価装置において、

照明手段からモニタ領域に照射される照明光として、モニタ領域の膜減りに伴う回折光の強度変化が極大・極小を有する波長の光を用い、

現像の終点を予測する手段は、

検出された回折光強度変化の極大・極小に基づいて現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項17】 請求項14のパターン寸法評価装置において、

照明手段からモニタ領域に照射される照明光として、モニタ領域の膜減りに伴う回折光の強度変化の時間微分値が極大・極小を有する波長の光を用い、

現像の終点を予測する手段は、

検出された回折光強度変化の時間微分値の極大・極小に基づいて現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項18】 請求項14のパターン寸法評価装置において、

照明手段からモニタ領域に照射される照明光として2以上の異なる波長の光を用いることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項19】 請求項14記載のパターン寸法評価装置において、

前記モニタ領域は、

デバイスパターンに対する現像終点に基づいて決定されたタイミングで所定の膜厚となるように露光されており、

前記現像の終点を予測する手段は、

前記モニタ領域が前記所定の膜厚となる回折光の強度を検出することで現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項20】 請求項14のパターン寸法評価装置において、

前記現像の終点を予測する手段は、

前記デバイスパターンからの回折光の強度が所定の値を超えたことに基づいて現像終点を予測するものであって、

前記現像終点を予測するために検出する所定の値は、現像開始直後の回折光の強度変化の大きい範囲に設定されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体装置の作製における光リソグラフィのレジストパターン形成技術に係わり、特に現像中若しくは現像後のレジストパターンを評価するためのパターン寸法評価装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 ウエハ上に集積回路パターンを形成するには、ウエハ上にレジストを塗布した後に該レジストに所望のパターンを露光し、さらに現像処理してレジストパターンを形成し、これをマスクにエッチング等の加工を行う。マスクとしてのレジストパターンには高い寸法精度が要求されるが、レジストパターンの寸法は現像時間により大きく変わる。このため、現像時間の制御が非常に重要である。

【0003】 従来、現像時の寸法制御は、先行ウエハを露光し、現像した後、その寸法評価を行って最も現像時間を決め、全てのウエハの現像時間を一定として行ってきた。しかし、実際にはそれぞれのウエハの引き置き時間といったウエハ履歴が異なっているために、同一ロットを同一現像時間で現像を行うとウエハ間に寸法ばらつきが生じ、所望寸法で現像を終わらせることができない。

【0004】 これまでこのような現像の時間管理を行っていても、寸法誤差が許容範囲内に入っていたため大きな問題とはなっていなかったが、プロセスの微細化が進みこれまで以上に精密な寸法制御が必要となってきており、従来の現像時間管理手法では現像時の寸法制御が困難となっている。

【0005】 一方、従来では現像後に行うレジストパターンの評価は、例えばSEM(Scanning Electron Microscope)を用いて行ってきた。SEMは高倍率のパターン観察が可能である反面、装置構成が複雑でかつ高価である。また、検査に非常に長い時間を要するため、効率良く評価することが困難であった。

【0006】 また、現像中や現像後に限らず、回折光等を利用して光学的にデバイスパターンを検査する場合、必要なデバイスパターンのモニタの際に他のデバイスパターンからの情報も取り込まれる可能性があり、これがモニタの精度を劣化させる要因となっていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 このように従来、現像時間の制御により異なるウエハに対してレジストバタ

ンの精密な寸法制御を行うことは困難であった。また、レジストパターンを SEM で評価するには多大な時間がかかるという問題があった。さらに、回折光等を利用してデバイスパターンを検査する場合、モニタすべきパターンとは別のパターンからの影響でモニタ精度が低下する問題があった。

【0008】本発明は、上記の事情を考慮して成されたもので、その目的とするところは、異なるウエハに対してレジストパターンの精密な寸法制御が可能となるパターン寸法評価装置を提供することにある。

【0009】本発明の他の目的は、モニタすべきパターンとは別のパターンからの影響を受けることなく、レジストパターンを短時間で高精度に検査することのできるパターン寸法評価装置を提供することにある。

【0010】本発明のさらなる他の目的は、レジストパターンの寸法を、その現像中に短時間でかつ高精度に評価でき、現像の終点を高精度に予測することのできるパターン寸法評価装置を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

(構成) 上記課題を解決するため、この発明のパターン寸法評価装置は、被処理体上の、デバイスパターンと異なる位置に形成されたモニタ領域に対し、特定波長の平行光を照射するための照明手段と、前記モニタ領域からの回折光強度を検出する手段と、このモニタ領域からの回折光強度に基づいて前記デバイスパターン寸法を評価するデバイスパターン評価手段とを有することを特徴とする。

【0012】この装置は、現像終了後のデバイスパターンの寸法を評価するのに適用されるものであっても良いし、デバイスパターンの現像終点を検出するのに適用されるものであっても良い。デバイスパターンの現像終点を検出するのに適用される装置である場合、前記パターン評価手段は、モニタ領域からの回折光の強度変化に基づいてデバイスパターンの現像の終点を判断する手段を有するものとする。

【0013】一方、モニタ領域としては、第1にモニタパターンを有するものであることが好ましい。このモニタパターンは、デバイスパターンとは異なる要素パターンで構成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されているものである。また、このモニタパターンは、露光用パターン要素の間隔が解像限界以下となるように隣接して周期的に配置してなる露光パターンを通してレジストを露光することで形成されたものであることが好ましい。

【0014】この場合、パターン寸法評価手段は、求められているデバイスパターン寸法とモニタパターンからの回折光の強度との関係に基づいてパターン評価を行なうようにすれば良い。

【0015】また、前記モニタ領域として、第2に、全体に亘って略均一の現像速度となるように露光され、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるよう形成されているものであっても良い。

【0016】この場合、このモニタ領域は、デバイスパターンを作成したマスクと同一面内に作成したマスクパターンを用いてデバイスパターンと同一条件で露光することにより作成するものであって、モニタ領域形成用のマスクパターンは、露光条件に対して被処理体上に0次回折光しか到達しないピッチを有する規則パターンであり、かつ、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるような透過率となるようにマスクパターンの抜きと残しの比率が設計されたマスクで作成されたものであることが好ましい。

【0017】そして、このようなモニタ領域を用いる場合、照明手段からモニタ領域に照射される照明光として、モニタ領域の膜減りに伴う回折光の強度変化もしくはその時間微分値が極大・極小を有する波長の光を用い、現像の終点を予測する手段は、検出された回折光強度変化もしくはその時間微分値の極大・極小に基づいて現像終点を予測するものであることが好ましい。

【0018】さらに、モニタ領域として、第3に、デバイスパターンに対する現像終点に基づいて決定されたタイミングで所定の膜厚となるように露光されたものであっても良い。この場合、前記現像の終点を予測する手段は、モニタ領域が前記所定の膜厚となったことを検出することで現像終点を予測するようすれば良い。

【0019】(作用) 本発明では、レジストの現像中又は現像後に、デバイスパターンや既加工パターンから識別可能な要素からなるモニタ領域を用いてパターン評価を行うことにより、レジストパターンの寸法を検査することができる。

【0020】そしてモニタ領域にモニタパターンを露光により形成する場合、例えば露光マスクの要素パターンとして円形又は多角形を用い、しかもそのパターン間隔が使用する露光装置の解像限界以下になるように構成した露光マスクを使用して露光を行なう。このようにして形成されたモニタパターンによれば、現像時間の経過による回折光の強度変化をデバイスパターンよりも大きくすることができ、これにより検査精度の向上をはかることができる。

【0021】また、ピッチ又は繰り返しの方向等が異なるモニタパターンを用いてパターン評価を行うことにより、他のパターンからの影響を受けない精度良い検査が可能となる。さらに、回折光強度をモニタするだけでパターン評価を行うことができるので、SEM等は異なり短時間で検査することができる。

【0022】一方、モニタ領域として、前記のようなパターンを有さず、ただ全体に亘って略均一の現像速度となるように露光され、現像の進行に伴い略均一に膜減り

が生じるように形成されているものを用いる場合、このモニタ領域からの回折光強度には極大・極小を観察することができる。そして、この極大、極小に基づいてデバイスパターンの現像終点を予測することができる。

【0023】このような予測方法によれば、回折光強度信号の絶対値に信号的なオフセットが生じている場合であっても、極大・極小に基づいてデバイスパターンの現像終点を予測するようにしたので、このオフセットを補正して正確な現像終点を求めることが可能になる。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明の詳細を図示の実施形態によって説明する。

【0025】(第1の実施形態)図1は、本発明の第1の実施形態に係わるパターン寸法評価装置を説明するためのもので、1次回折光を利用して現像後にパターン検査を行う装置構成例を示す図である。

【0026】ウエハ(被処理基板)100上のレジスト110には、デバイスパターン111と共にモニタパターン112が、一括露光、現像処理により形成されている。モニタパターン112は、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して配置されている。

【0027】モニタパターン112に対し、光源201から、狭帯域フィルタを介して $400 \pm 20 \text{ nm}$ とした波長の平行光を入射させる。モニタパターン112からは0次の回折光202、1次の回折光203、さらに高次の回折光(図示せず)が得られる。そして、モニタパターン112からの1次回折光203をCCDカメラ210によって検出する。このCCDカメラ210は、コンピュータシステムからなるパターン評価部220に接続されており、このパターン評価部220は、検出された1次回折光203の強度を予め得られている寸法と1次回折光強度との関係に適用し、デバイスパターン寸法の評価を行う。

【0028】図2は、本実施形態における現像モニタパターン112の例を示す図である。1辺の長さ $L = 0.2 \mu\text{m}$ (ウエハ換算値、以下同様)の正方形が規則的に配置されており、隣接する4つの正方形の中心が四角形の頂点になるように配置されている。x方向の間隔 d_x 、y方向の間隔 d_y は共に $0.07 \mu\text{m}$ である。ここで、間隔 d_x 、 $d_y = 0.07 \mu\text{m}$ は使用する露光装置の解像限界以下の値である。

【0029】デバイスパターン111として $0.15 \mu\text{m}$ *

$$I(m) \propto \frac{\sin^2(m\pi L/p)}{m^2 \pi^2} \{ |r_a|^2 + |r_b|^2 - 2|r_a||r_b|\cos(\phi_a - \phi_b) \}$$

【0040】この関係より、大きな強度変化を得るためにには、線幅の変化が $1/p = 0.25$ 又は 0.75 の近傍で起こっていることが必要である(図4)。

【0041】すなわち、(a)のモニタパターンは線幅

* m のL&Sパターンを想定した。露光条件は露光波長=248 nm(KrFエキシマレーザ)、投影光学系の開口数(NA)=0.7、コヒーレンスファクタ(σ)=0.75、2/3輪帯照明とし、レジストには $0.15 \mu\text{m}$ 膜厚のポジ型化学增幅レジストを用いた。

【0030】そして、 $0.15 \mu\text{m}$ のL&Sデバイスパターン(ライン幅:スペース幅=1:1)111が現像時間30秒で所望寸法に仕上がる条件で、モニタパターン112を以下の寸法として露光を行なった。すなわち、

(a)…図2に示したモニタパターン。

【0031】(b)… $0.15 \mu\text{m}$ のL&Sモニタパターン(ライン幅:スペース幅=1:1)。

【0032】(c)… $0.15 \mu\text{m}$ のL&Sモニタパターン(仕上がりのライン幅:スペース幅=1:3)。

【0033】(d)…ライン幅 $0.07 \mu\text{m}$ 、スペース幅 $0.2 \mu\text{m}$ のL&Sモニタパターン。

【0034】ここで(b)は、前記デバイスパターン111と同一寸法であるため、この(b)との比較により、デバイスパターン111に対する1次回折光の強度変化を知ることができる。

【0035】(a)～(d)それぞれの現像時間(10～36秒)に対する現像後の1次回折光強度の関係は、図3に示すようになる。このとき、(d)のパターンは全く解像していなかったため、図示されていない。

【0036】現像終点近傍(30秒)で(b)のパターンでは殆ど強度変化がなく、(a)のモニタパターンは(c)のパターンの約4倍の強度変化を示した。このとき、(a)のモニタパターンの強度変化は、(b)の

30 $0.15 \mu\text{m}$ のL&Sパターン(ライン幅:スペース幅=1:1)の寸法 $1.5 \mu\text{m}$ の変化に対して、10(CCDカメラの階調を256とした場合)である。

【0037】この原因として、以下のようなことがあげられる。

【0038】パターンの繰り返しピッチを p 、ライン部分の間隔、反射率、位相を 1 、 r_a 、 ϕ_a 、スペース部分の反射率、位相を r_b 、 ϕ_b とすると、L&Sパターンにおける m 次光の強度は(H. P. Kleinknecht and H. Meier, Applied Optics Vol.19 No.4 (1980) pp525-533)に見られるように、次の式で表される。

【0039】

【数1】

の変化が $1/p = 0.25$ の近傍で起こっているため、最も変化が大きくなっていると考えられる。また、

(a)のパターンと同じピッチだがスペース幅の異なる(d)のL&Sパターンは変化を示していないことか

ら、ホール状のパターンであることが重要であると考えられる。

【0042】このように本実施形態によれば、現像後に1次回折光強度よりパターン評価を行う場合に、1次回折光強度変化がデバイスパターン111の寸法変化に対して大きい寸法のモニタパターンを用いることにより、256階調のCCDカメラの10階調で寸法変化1.5nmの計測ができることが分かる。

【0043】すなわち、デバイスパターン111の0.15μmのL&Sパターン（ライン幅：スペース幅=1:1）では、寸法の5%の変動（7.5nm）に対して、階調が1階調しか変化していない。これに対して、パターン間隔が使用する露光装置の解像限界以下の値であるモニタパターン（a）をモニタするようにすれば、より多くの階調でこの寸法変動を検出することができるから測定精度が大きく向上する。

【0044】また、光学的な手法でパターン評価を行うようにしたことから、容易なウェハのパターン評価が可能となり、スループットが向上する。さらに、1024階調のCCDカメラでモニタを行えば、単純に4倍の精度でモニタが可能である。

【0045】（第2の実施形態）図5は、本発明の第2の実施形態を説明するためのもので、1次回折光を利用し、現像中にパターン検査を行う際の装置構成例を示す図である。即ち、1次回折光を利用したin-situ現像モニタの例である。

【0046】基本的な構成は前記図1と同じであるが、レジスト110上には現像液230が存在し、その上に円盤状のノズル240が設置された状態となっている。また、前記CCDカメラ210は、現像時間等のプロセス条件を制御する現像制御装置241に接続されており、この現像制御装置241には、前記モニタパターン112からの回折光の強度に基づいてデバイスパターン111の現像終点を予測する現像終点予測部220'が設けられている。

【0047】この装置においても、現像中に、モニタパターン112に対し、狭帯域フィルタを介して400±20nmとしたレジストが感光しない波長の平行光201を斜め方向から入射させる。モニタパターン112は、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して配置されているが、デバイスパターン111とモニタパターン112のピッチが異なるように設計されている。

【0048】具体的には、図6に示すように、デバイスパターン111としては、非常に近接した領域に0.15μmのL&Sパターン251或いはピッチ0.30μmのホールパターン252が存在する。また、現在加工中の下層には既加工の層が存在し、その層にはデバイスパターンである0.15μmのL&Sパターン或いはピッチ0.3μmのホールパターンが存在する。

【0049】一方、モニタパターン112としては、前記図2に示したものと同じパターンを用いる。すなわち、このモニタパターン112は、1辺の長さL=0.2μmの正方形が規則的に配置され、x方向の間隔dx、y方向の間隔dyは共に0.07μmである。ここで、間隔dx、dy=0.07μmは使用する露光装置の解像限界以下の値である。

【0050】現像モニタパターン112からの1次回折光203をCCDカメラ210により検出する。前記現像終点予測部220'は、検出した1次回折光を予め得られている現像時間と1次回折光強度との関係と照合し、所望の値に1次回折光強度がなった時点で現像の終点とする。前記現像制御装置241は、この検出に基づいて現像を終了する。

【0051】この実施例においては、前記デバイスパターン111とモニタパターン112のパターンピッチを異なさせたので、両者を区別して認識することが可能である。

【0052】すなわち、図5における入射角を40°とした場合、検出角とパターンピッチの関係は図7のようく表される。この図によれば、ピッチ0.27μmの場合の検出角は57°、ピッチ0.30μmの場合の検出角は44°である。したがって、非常に近接した領域にデバイスパターン111とモニタパターン112が存在しても、パターンピッチが異なればデバイスパターン111及び既加工パターンからの1次回折光とモニタパターン112からの1次回折光は分離可能である。

【0053】このように本実施形態によれば、デバイスパターン111及び既加工パターンと異なるピッチのモニタパターン112を用いることにより、モニタパターン112以外の回折光の影響を受けない精度の良いモニタが可能となる。このため、現像終点を正確に判断することができ、レジストパターンの精密な寸法制御を行うことができる。

【0054】（第3の実施形態）本実施形態は、第2の実施形態と同様の装置構成（図5）を有するが、モニタパターン112の配置が異なるものである。

【0055】この装置は、現像中に、モニタパターン112に対し、狭帯域フィルタを介して390±10nmとしたレジストが感光しない波長の平行光201を斜め方向から入射させる。モニタパターン112は、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して配置されているが、前記第2の実施形態と異なり、デバイスパターン111とモニタパターン112の繰り返しの方向が異なるように設計されている。

【0056】具体的には、図8に示すように、非常に近接した領域にデバイスパターン111であるピッチ0.27μmのL&Sパターン252或いはピッチ0.27μmのホールパターン251が存在するが、これらのデバイスパターン251、252は、隣接するモニタバタ

ーン111と繰り返しの方向が15°異なるように形成・配置されている。

【0057】ここで、現像モニタパターン112からの1次回折光203をCCDカメラ210により検出する。検出した1次回折光強度の時間微分値を、予め得られている現像時間と1次回折光強度との関係と照合し、所望の値に1次回折光強度の微分値がなった時点で現像の終点とする。

【0058】図8に矢印(α)で示す方向から、パターン面に約30°の角度で光を入射させると、モニタパターン112からの1次回折光は入射光と同じ方向でかつパターンに垂直な方向に検出されるが、デバイスピターン111からの1次回折光は入射光とは異なる方向に検出されることになる。従って、繰り返しの方向が異なれば、ピッチが同じでも1次回折光が分離可能である。

【0059】本実施形態によれば、デバイスバターン111及び既加工バターンと異なる繰り返し方向のモニタバターン112を用いることにより、モニタバターン112以外からの1次回折光の影響を受けない精度の良いモニタが可能となり、第2の実施形態と同様にレジストバターンの精密な寸法制御を行ふことができる。

【0060】(第4の実施形態) 本実施形態も、第2の実施形態と同様の装置構成(図5)を有するが、モニタパターン112の配置が異なるものである。

【0061】この装置も、現像中に、モニタバターン112に対し、狭帯域フィルタを介して $390 \pm 10 \text{ nm}$ としたレジストが感光しない波長の平行光201を斜め方向から入射させる。ただし、モニタバターン112の下層には、図9に示すようにピッチ0.3 μm の既加工のモニタバターン112'が存在する。

【0062】加工中のモニタパターン112としては、前記図2に示したのと同寸法のパターンを用いる。ここで、間隔 $d_x, d_y = 0.07 \mu\text{m}$ は使用する露光装置の解像限界以下の値である。

【0063】現像モニタバターン112からの1次回折光203をCCDカメラ210により検出する。予め得られている現像時間と回折光強度との関係を基に、1次回折光強度が極値を取る現像時間から現像の終点までの時間差を算出し、この値を参照して現像の終点を検出する。

〔0064〕前記図5における入射光の入射角を40°として、検出角とピッチの関係は前記図7に示すように表される。ピッチ0.27μmの場合の検出角は57°、ピッチ0.30μmの場合の検出角は44°であることから、層によって異なるモニタバターンを用いれば、下の層からのモニタバターン112'からの1次回折光と現加工のモニタバターン112からの1次回折光は分離可能である。

【0065】本実施形態によれば、モニタパターンとして各層毎に異なるピッチのモニタパターンを用いたもの

で、下層のモニタパターンからの1次回折光の影響を受けない精度の良いモニタが可能となり、第2の実施形態と同様にレジストパターンの精密な寸法制御を行うことができる。

【0066】(第5の実施形態) 図10は、本発明の第5の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にパターン検査を行う際の装置構成例を示す図である。即ち、0次回折光を利用してした *in-situ* 現像モニタの例である。

10 【0067】この装置は、現像中に、前記モニタバターン112に対し、コリメートされた波長488nmのレーザ光301を垂直に入射させる。そして、現像モニタバターン112からの回折光（0次回折光302、1次回折光303等）のうち0次回折光302のみをCCDカメラ210により検出する。現像制御装置240（現像終点予測部220'）は、CCDカメラ210のピクセル輝度をコンピュータ処理することで0次回折光強度を算出し、これに基づいてデバイスバターン111の現像終点を予測する。

20 【0068】図11は、本実施形態における、現像モニタバターン112を露光用マスク上でのイメージとして表したものである。1辺の長さ $L = 0.2\mu\text{m}$ の正方形が規則的に配置されており、敷き詰められた三角形の頂点位置が正方形の中心となるように配置されている。x方向の間隔 d_x 、y方向の間隔 d_y は共に $0.06\mu\text{m}$ であり、使用する露光装置の解像限界以下の値である。この正方形は、実際のウエハ上には円形のホールとして転写されるため、モニタバターン112はホールを敷き詰めたバターンとなっている。

30 【0069】デバイスバターン111として $0.15\mu\text{m}$ のL&Sバターンを想定した。露光条件は露光波長=248nm（KrFエキシマレーザ）、投影光学系の開口数（NA）=0.7、コヒーレンスファクタ（ σ ）=0.75、2/3輪帯照明とし、 $0.15\mu\text{m}$ 膜厚のポジ型化学増幅レジストを用いた。

【0070】図12に、現像時間と0次回折光強度の関係を示す。デバイスバターンの現像終点時間30秒において、現像モニタバターン112における0次回折光強度の変化がデバイスバターン111と比較して3倍となつた。バターンからの0次回折光強度は現像残し面積に比例する量であり、強度変化が大きいということは、面積変化が大きいことを意味する。

40 【0071】このようにモニタバターンで大きな強度変化が得られた理由として、(1)ホールバターンの形状変化が円の外周方向で大きくなる方向であること、(2)ホールが密に配置されているために、3つの隣接するホールバターンで囲まれた領域が解像限界以下であること、(3)現像残し部分の形状が先細りであること、等があげられる。

50 【0072】図11に示す現像モニタバターン（ $L =$

0.2 μm、d x = d y = 0.06 μm) を用いることによって、CCDカメラを用いた場合、0.15 μmのL&Sパターンの1.5 nmの寸法変化(1%)を6階調でモニタでき、0.15 μmのL&Sパターンの場合の2階調と比較して、より精密な線幅の制御が可能となる。また、1024階調のCCDカメラを用いれば、さらに精密な線幅の制御が可能となる。

【0073】(第6の実施形態) 図13(a)は本発明の第6の実施形態を示す概略構成図である。なお、すでに述べた実施形態(特に第2の実施例を参照)と同一の構成要素については同一符号を付してその説明は省略する。

【0074】図に405で示すのはモニターヘッドである。このモニターヘッド405は、狭帯域フィルターで波長330±5 nmに整形された平行光出射する光源401と、モニターパターン112からの1次回折光を画像として認識する1次回折光検出器402と、デバイスパターン111からの0次回折光を画像として認識できる0次回折光検出器403とを有する。

【0075】このモニターヘッド405は、更に、反射光学系404を有する。この反射光学系404は、ウェハ100側からの入出射光を、前記光源射光ガイド401、1次回折光検出器402及び0次回折光検出器403に対して略垂直にガイドする機能を有する。

【0076】この図13(a)の例では、レジスト110上には現像液230が存在し、その上に円盤状のノズル240が設置された状態となっており、前記モニターヘッド405は、入出射面をこの円盤状のノズル240に対向させて配置されている。

【0077】なお、図13(b)、(c)に示すのは、このモニターヘッド405の他の配置例である。すなわち、図13(b)は、前記モニターヘッド405が現像液230の直上に設置されている例、図13(c)は、モニターヘッド405が現像液230に接した状態で配置されている例である。なお、図5に示したものと同様に、このモニターヘッド405の先端部が前記ノズル240内に挿入されていても良い。

【0078】また、前記モニターヘッド405は、このモニターヘッド405をXYZ方向に位置決め駆動するための駆動機構406により保持され、この駆動機構406は図に407で示す現像制御装置により制御されるようになっている。さらに、この現像制御装置407には、前記1次回折光検出器402及び0次回折光検出器403が接続されており、この制御装置407により前記モニターパターン112及びデバイスパターン111の位置検出がなされる。また、この現像制御装置407には、現像終点予測部220'が設けられており、この現像終点予測部220'は前記0次回折光の強度に基づいて現像終点を予測するように構成されている。

【0079】モニターパターン112としては、例えば図

14(a)～(c)で示したパターンを用いる。図14(a)に示したパターン112は、すでに図2に示して説明したものと同一である。このモニターパターン112は、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して配置されている。

【0080】この実施形態では、モニターパターン112に対する入射光の入射角(以下示す角度は全てモニターパターン112に対する角度)を60°、モニターパターン112からの1次回折光(107)の検出角度を20°、0次回折光(108)の検出角度を60°に設定されている。

【0081】次に、この装置の作用を説明する。

【0082】図15(a)中408はウェハであり、409はこのウェハ408上の1チップを示している。現像開始後、前記モニターヘッド405は図15(b)に示す前記1チップ409内のモニターパターン領域に、ショットマップ、マスクのデータをもとに移動し、1次回折光および0次回折光の検出を開始する。このモニターヘッド405では一度に2×2 mmの領域の観察が可能である。

【0083】前記モニターパターン112は、すでに第2の実施形態で説明したものと同様に、デバイスパターン111及び既加工パターンと異なるピッチで形成されており、入射光の入射角度についても、モニターパターン112からの1次回折光のみがモニターヘッド405の1次回折光検出器402で検出されるような角度に定められている。

【0084】したがって、前記1次回折光検出器402にはピッチ0.27 μm以外のパターン(デバイスパターン111及び既加工パターン)からの光は検出されないので、図16(a)に示すように、1次回折光検出器の検出画面では、モニターパターン112の部分だけが光っているように検出される。

【0085】一方、0次回折光検出器403では、図16(b)に示すように、デバイスパターン111およびモニターパターン112の両方が画像として検出される。そして、0次回折光検出器403と1次回折光検出器402のそれぞれの画像のピクセルの位置関係はあらかじめわかっているので、1次回折光検出器402と0次回折光検出器403で検出された領域の論理積より、図16(c)に示すように、0次回折光検出器402の検出画像内でのモニターパターン112の位置検出が行なえる。

【0086】以上のような検出がなされたならば、制御装置407は、現像中のウェハ100の回転に追随するよう前記モニターヘッド405を移動・回転駆動させ、0次回折光強度をモニターする。そして、前記現像終点予測部220'は、あらかじめ得られているデバイスパターン111の寸法とモニターパターン112の0次回折光強度の関係を参照し、回折光強度が所望の値に

なった時点で現像の終点とする。

【0087】このような実施形態によれば、現像中に0次回折光・1次回折光の検出および走査が可能な一体型のモニターヘッド405を用い、モニターパターン112からの1次回折光検出位置からモニターパターン112の位置を検出するようにした。したがって、デバイスパターン111が非常に狭い領域にある場合や、デバイスパターン111とモニターパターン112の形状が似ていて近接している場合でも、大幅な光学系の変更を行うことなくモニターパターン112の位置検出が可能である。

【0088】なお、前記制御装置407（現像終点予測部220'）では、0次回折光および1次回折光の両方の光強度をモニターするようにしても良い。すなわち、あらかじめ得られているデバイスパターン111の寸法とモニターパターン112の0次および1次回折光強度の関係を参照し、デバイスパターン111が所望寸法に仕上がっているかを判断する。

【0089】このように0次回折光と1次回折光を同時にモニターすることにより、測定の精度がさらに向上する。

【0090】なお、この実施形態に示すモニタヘッド405を、現像後にパターン寸法評価を行なう装置に適用することはもちろん可能である。

【0091】また、

（第7の実施形態）図17はこの実施形態を示す概略構成図である。なお、第6の実施形態と同一の構成要素には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

【0092】この実施形態のモニターヘッド501に設けられた反射光学系502は、光源401から出射された光の前記モニターパターン112（若しくはデバイスパターン111）への入射角度を、0次回折光が0次回折光検出器403へ略垂直に戻るような角度に制御するよう構成されている。すなわち、この実施形態の0次回折光検出器403は、前記モニターパターン112で回折した0次回折光を直接検出するように構成されている。

【0093】また、この反射光学系502には、図に503、504で示す一対のハーフミラーが配置されている。一方のハーフミラー503は、入射光路上に配置され、入射光の一部を他方のハーフミラー504側に分岐させる。この他方のハーフミラー503は、前記分岐した入射光を反射し、前記0次回折光の光路と一致させた状態でモニターパターン112に照射する。また、この他方のハーフミラー503は、前記モニターパターン112からの0次回折光について、これを透過させ前記0次回折光検出器403に導くようになっている。

【0094】ここで、入射光のモニターパターン112に対する入射角を60°とし、モニターパターン112からの1次回折光の検出角度は20°と設定されている。また、0次回折光の検出角度は0°である。

【0095】このような構成によれば、まず、前記第6の実施形態と同様の制御を行なうことにより、モニターパターン112からの0次回折光のモニタを行なうことができ、これによりデバイスパターン111の現像を精度良くモニターすることができる。また、この実施形態によれば、次に説明するように、レジスト（モニターパターン112）の残し面積を、より精度良くモニターできる効果がある。

【0096】すなわち、図18（a）に示すように、斜入射ではレジストのトップにあたる入射光505とレジストパターン間にあたる入射光506が存在するため、0次回折光はレジストの残し面積を直接反映しない。

【0097】しかしながら、この実施形態では、図18（b）に示すように、垂直入射となるため、0次回折光の強度はレジストからの0次回折光507と反射防止膜からの0次回折光508の和として表される。このため、レジストの残し面積を直接反映することになる。従って、第6の実施形態と比較して、レジストの残し面積を反映した光の強度の取得が可能であるから、より精度の高いモニターが行なえる。

【0098】なお、この実施形態の装置においても、図13（b）、（c）に示すように各種の装置配置が考えられる。また、この実施形態に示すモニタヘッドを、現像後にパターン寸法評価を行なう装置に適用するようにしても良い。

【0099】（第8の実施形態）図19は、この実施形態を示す装置構成図である。なお、第6、第7の実施形態と同様の構成については同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

30 【0100】この実施例のモニターヘッド601は、図に602で示す入射・0次回折光検出光学系を有する。この光学系602は、狭帯域フィルターで260±5nmとした波長の平行光をモニターパターン側に入射させると共に、このモニターパターンからの0次回折光をイメージとして検出できるように構成されている。また、モニターパターンからの1次回折光は、図に603で示す1次回折光検出器によって検出されるようになっている。

【0101】この実施形態では、入射光のモニターパターン112に対する入射角（以下示す角度は全てモニターパターンに対する角度）を0°、モニターパターン112からの1次回折光の検出角度は74°、0次回折光の検出角度は0°と設定されている。

【0102】このような構成によれば、第6の実施形態と同様の制御により、現像のモニタを行なえる。また、モニターパターン112への入射光の光路が0次回折光の光路と一致しているので、第7の実施形態と同様に、レジスト残り面積を反映した0次回折光の検出が行なえる。

【0103】なお、この実施形態の装置においても、図13（b）、（c）に示すように各種の装置配置が考え

られる。また、この実施形態に示す構成を、現像後にパターン寸法評価を行なう装置に適用することはもちろん可能である。

【0104】(第9の実施形態) 第9の実施形態以下の各実施形態は、第1～第8の実施形態と異なる形態のモニタ領域を用いてモニタを行なうものである。ただし、第1～第8の実施形態の構成要素と同一の構成要素には同一符号を付し、その詳しい説明は省略する。

【0105】すなわち、第1～第8の実施形態では、モニタ領域として、図2に示すようにホールを敷き詰めてなるパターン112を用いていたが、この実施形態では、図20に示すように、パターンを有せずただ露光量を調整することにより現像速度を所望の値に調整してなる一定面積のエリアを使用してモニターを実行するようにしたものである。以下、この実施形態でモニタするエリア(図20)を”モニタエリア701”と称することとする。

【0106】この実施形態では、前記デバイスパターン111の現像中に、このモニタエリア701からの0次回折光の強度をモニターし、このモニタエリア701の膜厚が所定の値になったところで現像を終了することで、デバイスパターン111を所望の寸法に仕上げるものである。

【0107】以下、まず、前記モニタエリア701の形成手順について詳しく説明する。

【0108】この実施形態では、ウエハ100上に塗布したレジスト110の所定面積のエリアを露光マスクからの0次回折光のみを用いて露光することで、前記モニタエリア701を形成する。すなわち、0次回折光のみを用いた露光を行うことでレジスト110上にホールやライン等の「パターン」が形成されることを防止する。

【0109】露光マスクを用いて露光する際に、この露光マスクからの0次回折光だけがレジスト110上に到達するための露光条件は、露光波長λ、マスクパターンのレジスト上換算のピッチp、NA、及びσを用いて次のように定められる。

【0110】

$$\lambda/p \geq (1+\sigma) NA \quad (2)$$

したがって、この式に基づいてモニタエリア701用の露光マスク上に設けるのパターンのピッチを定めるようになる。このようなピッチの露光パターンを有する露光マスクによれば、露光マスクを透過した光のうち0次回折光のみがレジスト110上に達するから、レジスト上にパターンが成形されるのを防止できる。

【0111】また、この実施形態では、露光マスクの線幅の調整により透過率を適宜に設定することで、レジスト110に対する露光強度を制御し、この露光により形成したモニタエリア701の現像速度がモニタに適した値となるように調整する。すなわち、レジスト110の膜厚とレジスト110に対する標準の現像時間とからデ

バイスパターン111に対する現像の終了時点でこのモニタエリア701のレジストが少し残るような現像速度を算出する。

【0112】次に、求めた現像速度とレジスト110の溶解特性から、この現像速度となる露光量(モニタパターン701を形成するための露光量)を算出する。そして、デバイスパターン111を形成するための最適露光量と前記モニタパターン701を形成するための露光量の比から、デバイスパターン111用の露光マスクに対するモニタエリア701用の露光マスクの透過率を算出する。

【0113】したがって、モニタエリア701用の露光マスク上に、前記(2)式を満たすピッチで、かつ、デバイスパターン用の露光マスクに対して前記のような透過率となる線幅でモニタエリア用の露光用マスクパターンを形成するようにする。

【0114】例えば、 $0.15 \mu\text{m}/\text{s}$ パターンの露光条件(NA: 0.6、露光波長: 248 nm、σ: 0.75)では、レジスト110上に0次回折光しか到達しないような露光用マスクパターンのピッチは $0.22 \mu\text{m}$ となる。そして、モニタエリア701の現像速度が $2 \text{nm}/\text{sec}$ (60秒の現像で膜厚が30 nmになる)となる露光量が 7.2mJ である場合において、デバイスパターン111の最適露光量が 20mJ であるとすると、前記透過率は36%となる。

【0115】従って、この場合、ピッチが $0.22 \mu\text{m}$ で、ライン幅が透過率が36%となるように設計されているライン系パターンをモニタエリア701形成用の露光用マスクパターンとして採用することで、所望のモニタエリア701を形成することができる。

【0116】次に、このようなモニタエリア701を用いて、現像をモニタする装置構成について、図21を参照して説明する。

【0117】この図21において、ウエハ(被処理基板)100上のレジスト110には、デバイスパターン111と共にこの実施形態のモニタエリア701が、前述した一括露光により形成されている。このモニタエリア701は、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して配置されている。

【0118】また、この装置は、前記第2の実施形態のものと同様に、現像中に適用される寸法モニタ装置であるから、レジスト110上には現像液230が存在する。

【0119】この装置は、光源702から波長410 nm(半値幅5 nm)に狭帯化したほぼ単色の平行光を前記モニタエリア701に入射させる。そしてモニタエリア701からの0次回折光は0次回折光検出器(CCDカメラ)703により検出するようになっている。

【0120】前記光源702及び0次回折光検出器703は、制御部704に接続されおり、この制御部704

からの作動信号に基づいて動作する。すなわち、まず、前記制御部704は、0次回折光検出器703による0次回折光の検出に基づいて、光源及702及び0次回折光検出器703を前記モニタエリア701に対向する位置に駆動・位置決めする。そして、現像の開始に伴い、前記0次回折光検出器704を用いたモニタを開始する。

【0121】このモニタは、前記モニタエリア701からの0次回折光の強度を検出することで行う。すなわち、理想的な場合、モニタエリア701の膜厚に対する0次回折光の強度変化は図22に示すように、極大点I'max、極小点I'minを有するカーブで表される。ここで、現像終点となる膜厚での0次回折光の強度をI'endとすると、I'endは、極大点I'max、極小点I'minを用いて次のように表せる。

【0122】

【数2】

$$I'end = I'min + (I'max - I'min) \times a$$

$$a = \frac{I'end - I'min}{I'max - I'min}$$

【0123】ここで、aは補正係数であり、予め先行ウエハ等を用いて測定した極大、極小における0次回折光強度I'max、I'min、I'endと、現在の現像で測定した極大、極小における0次回折光強度I'max、I'minとから求められる。この補正係数aを現在の測定値I'max、I'minに適用することで、現像終了点の0次回折光強度I'endを求めることができる。そして、前記現像終点予測部220'は、前記0次回折光検出器703により検出された光強度がI'endとなった時点で現像を終了させる。

【0124】なお、この実施例で重要なことは、前述のように0次回折光の強度変化の極大、極小に基づいて現像終了時点を予測している点である。したがって、前記光源702から発振される観察光として、このような極大、極小が得られるような波長を有するものを選択して用いる必要がある。

【0125】なお、この例では、現像終了の判断と実際の現像終了との間に極端な時間差がないものとして説明しているが、無視できない時間差が存在する場合は、モニタエリア701に対する露光強度としてその時間差に相当する分を差し引いた強度を設定すれば良い。

【0126】このような構成によれば、モニタエリア701からの0次回折光の強度変化をモニタすることで現像時間を制御できるから、第1～第8の実施形態と同様の効果を得ることができる。

【0127】また、この実施形態によれば、パターンを持たないモニタエリア701を用いることで、以下に説

明する効果を得ることができる。

【0128】すなわち、この実施形態では、パターンを有しないモニタエリア701からの0次回折光をモニタすると共に、光強度の極大、極小に基づいて現像終了点を予測するようにした。このような構成によれば、光強度信号にオフセットが生じた場合であっても、光強度の絶対値ではなく、既知の極大、極小、現像終点に基づいて求めた補正係数を現在の測定値に適用することで現像終点を正確に予測できる。

10 【0129】これに対して、第1～第8の実施形態では、0次回折光の強度信号の絶対値を用いてモニタを行っている。このような方法では、何らかの原因で信号にオフセットが生じた場合に、デバイスパターンの現像終点を正確に検出できない恐れがある。また、入射光をモニタパターンの直上から照射し、その0次回折光を検出する構成では、強度信号がパターンの残り面積を反映してしまうため、0次回折光の強度は、図12に示すように現像時間に対して直線的に変化することになる。したがって、この場合も、強度信号の絶対値を用いてモニタすることになってしまい、やはり現像終点を正確に検出できない恐れが生じる。

20 【0130】この実施形態の制御によれば、この様な欠点を排除し、上述したように、より正確に現像終点を検出できる効果がある。

【0131】なお、この第9の実施形態では、パターンを有しないモニタエリア701を使用したが、このモニタエリアの形成方法はこの実施形態に挙げたものに限定されるものではなく、適宜他の方法を用いて形成するようにしても良い。たとえば、この実施形態では、所定のピッチ、線幅を有する露光パターンを用いた露光により前記モニタエリア701を形成するようしたが、透過率を適宜に設定したハーフトーン膜を露光マスクとして形成するようにしても良い。

30 【0132】(第10の実施形態)この実施形態は、第9の実施形態の具体例を示すものである。

【0133】図23はこの実施形態を示す概略構成図である。

【0134】まず、この実施形態では、前記光源702は、グレーティングにより分光可能なランプハウス801と、このランプハウス801に接続された光ファイバ802と、この光ファイバ802の先端に取り付けられたコリメーションレンズ803とからなる。前記光ファイバ802の先端部及びこのコリメーションレンズ803は、XYZ方向に移動可能なモニタヘッド804により保持されている。

【0135】前記ランプハウス801からの平行光は、光ファイバ802、コリメーションレンズ803を通して前記モニタエリア701に入射する。このモニタエリア701からの0次回折光は、前記モニタヘッド804に保持されたレンズ805、このレンズ805に接続さ

れ先端部を前記モニタヘッド804に保持された光ファイバ806を通して前記0次回折光検出器703(CCDカメラ)に検知されるようになっている。

【0136】前記モニタヘッド804は、モニタヘッド駆動装置807によって駆動されるようになっていて、このモニタヘッド駆動装置807は、前記制御部704の指令により作動するよう構成されている。

【0137】すなわち、このモニタヘッド804はモニタエリア701の位置に移動し、モニタエリア701からの0次回折光の強度を検出する。このとき、モニタヘッド804はウェハのショットマップおよびマスクのレイアウトをもとにモニタエリア701に移動し、その後は、現像中のウェハの回転に同期させてモニタエリア701の強度を取得する。

【0138】なお、この際、複数のモニタヘッドを用いるようにして、検出精度を高めるようにしても良い。また、モニタヘッド804は、図13(a)～(c)や図5に示すような配置であっても良い。また、モニタヘッド804の形状も、図13に示した形状のもの他、適宜の形状を採用することが可能である。

【0139】(第11の実施形態)この実施形態は、第9の実施形態、第10の実施形態と同様に、現像中にモニタエリア701からの0次回折光をモニタし、現像終了時点を判断する装置である。ただし、第9の実施形態では現像の終了点を0次回折光の強度に基づいて判断したが、この実施形態では、現像時間に基づいて判断する。その他の点は、第9若しくは第10の実施形態と同様であるから説明を省略する。

【0140】図24は、レジスト110の膜厚と0次回折光の強度の関係を示すグラフである。この実施形態では、光強度が極大、極小となる現像時刻 t'_{\max} 、 t'_{\min} から、現像終点となる現像時刻 t'_{end} を予測し、この現像時刻 t'_{end} で現像を終了させようとしたものである。

【0141】なお、プロセス条件が常に一定であれば、現像終点となる時刻は一定である。しかし、実際にはプロセス条件にはゆらぎがあるため、現像終了時刻は一定にはならない。今、露光量の条件が所望の値の-5%変動したとすると、現像時間に対するレジスト膜の膜減りはレジストの溶解特性より図25に示す通りに変化する。このときの極小値、極大値、現像終点となる時間を*

$$I'_{\text{end}} = I'_{\min} + (I'_{\max} - I'_{\min}) \times a$$

$$a = \frac{I'_{\max} - I'_{\min}}{I'_{\max} - I'_{\min}} + \frac{I'_{\max} - I'_{\min}}{I'_{\max} - I'_{\min}} \times 1/2$$

【0149】この様な構成によれば、異なる波長の光を用い、一方の波長の光の検出値に加えて他方の波長の光

*それぞれ、 t'_{\max} 、 t'_{\min} 、 t'_{end} とする。そして、この実施形態では、次式に示すように、予め求めておいた現像終了時刻 t'_{end} に補正係数 a をかけることで、現在の現像プロセスにおける現像終了時刻 t'_{end} を予測する。

【0142】 $t'_{\text{end}} = a \times t_{\text{end}}$

補正係数 a は、次式で求められるもののうちもっとも精度が良いものを用いるようにすれば良い。

【0143】 $a = t'_{\max} / t_{\max}$

10 $a = t'_{\min} / t_{\min}$

$$a = (t'_{\max} / t_{\max} + t'_{\min} / t_{\min}) / 2$$

なお、現像終了時刻 t'_{end} の定め方はこの方法に限定されるものではなく、極値となる時刻時間 t'_{\max} 、 t'_{\min} に基づいて予測するものであれば、例えば t'_{\max} から一定の時間の後を現像終了時刻とする等、適宜の方法を採用することが可能である。

【0144】(第12の実施形態)この実施形態は、第9、第10の実施形態と同様にモニタエリアからの0次回折光をモニタするものであるが、互いに異なる波長を有する2種類の観察光を用いてモニタを行うものである。

【0145】すなわち、この実施形態では、図23に示す構成において、ランプハウス801から、波長410nm(半値幅5nm)に狭帯化した光と波長600nm(半値幅5nm)に狭帯化した光を交互に射出するように制御する。

【0146】制御部704は、前記CCDカメラ703により、両方の波長の0次回折光の強度を交互に検出する。理想的な場合、各波長でのレジスト膜厚に対する0次回折光の強度変化は図26に示すようになる。

【0147】ここで、波長410nmの場合の極大、極小、現像終点での0次回折光の強度を $I_{1,\max}$ 、 $I_{1,\min}$ 、 $I_{1,\text{end}}$ 、波長600nmの場合の極大、極小となる強度を $I_{2,\max}$ 、 $I_{2,\min}$ とする。一方、今回の現像で検出された波長410nmの場合の極大、極小での0次回折光の強度を $I_{1,\max}'$ 、 $I_{1,\min}'$ 、波長600nmの場合の極大、極小となる強度を $I_{2,\max}'$ 、 $I_{2,\min}'$ すると、現像終点の強度 I'_{end} は、補正係数 a を用いて次式で求められる。

40 【0148】

【数3】

の測定値を用いて補正を行うようにしたから、現像終了時点の0次回折光強度をより精度良く予測することが可

能になる。

【0150】なお、この実施形態のように2つの異なる波長を用いて補正精度を擧げる手法は、第11の実施形態に示したように極大、極小となる時刻 t_{max} 、 t_{min} から、現像終了となる時刻 t_{end} を予測する方法にも適用できる。

【0151】すなわち、理想的な場合、410nm、470nmの各波長を有する光でのレジスト膜厚に対する0次回折光の強度変化は図27に示すようになる。

【0152】このとき、波長410nmの光の0次回折光強度が極小、極大、現像終点となる時刻をそれぞれ、 $t_{1,max}$ 、 $t_{1,min}$ 、 $t_{1,end}$ とする。また、波長470nmの光の0次回折光強度が極大となる時刻を $t_{2,max}$ とする。プロセス条件が常に一定であれば、現像時間は常に一定でよいが、実際にはプロセス条件にゆらぎがある。今、露光量の条件が所望の値の-5%であったとすると、現像時間に対する膜減りはレジストの溶解特性より図28に示すようになる。

【0153】このとき、波長410nmの光の0次回折光強度が極小、極大、現像終点となる時間をそれぞれ、 $t_{1,max}$ 、 $t_{1,min}$ 、 $t_{1,end}$ とし、波長470nmの光の0次回折光強度が極大となる時刻を $t_{2,max}$ とする。これらの時間のうちあらかじめ $t_{1,max}$ 、 $t_{1,min}$ 、 $t_{1,end}$ 、 $t_{2,max}$ は求められており、現像中に0次回折光を検出することにより、 $t_{1,max}$ 、 $t_{1,min}$ 、 $t_{1,end}$ 、 $t_{2,max}$ が算出される。これらより次の式で現像終了点の時間 $t_{1,end}$ を求めることができる。

【0154】 $t_{1,end} = a \times t_{1,end}$

$$a = (t_{1,max}/t_{1,max} + t_{1,min}/t_{1,min} + t_{2,max}/t_{2,max}) / 3$$

したがって、第11の実施形態と同様に、時刻 $t_{1,end}$ で現像を終了するようにすれば、現像の終点を正確に制御できる。

【0155】(第13の実施形態) この実施形態は、第9の実施形態と同じように、モニタエリア701からの0次回折光をモニタするものであるが、レジスト110として、図29に示すように、現像開始当初は膜減りが起こらず、数秒後から膜減りが開始するような溶解特性を有するものを採用する。

【0156】このモニタエリア701は、前記デバイスパターン111の現像終了時に膜減りが開始するように設計する。すなわち、60秒の現像した後に膜減りが始まるような露光量が6.6mJであるレジストを用いる場合、デバイスパターン111の最適露光量が30mJであるので、デバイスパターン用露光マスクと比較して透過率が22%となるようにモニタエリア用の露光マスクを設計する。

【0157】図30にモニタエリア701に対する膜抜け時間と露光量との関係、図31にモニタエリア701に対する膜抜け開始時間と露光量との関係を示す。

【0158】プロセス条件が常に一定であれば、現像時間は常に60秒で制御すればよいが、デバイスパターン111の露光量が適正值の30mJから29mJに変化した場合には、60秒では十分な現像が行なえないことになる。しかしながら、この実施形態では、モニタエリア701の膜抜け開始時点を検出することで、このようなプロセス条件の変動にも対応でき、常に正確な終点制御を行なえる。

【0159】すなわち、デバイスパターン111の露光量が適正值の30mJから29mJに変化した場合、モニタエリア701の露光量はその22%であることから、モニタエリア701に対する露光量は6.4mJとなる。従ってこの場合、図31より、80秒後に膜抜けが開始する。したがって、この膜抜けを検出して現像の終点とすることで、プロセス条件の変動にも対応することができる。

【0160】なお、膜の抜け始め及び抜け終わりの検出は、0次回折光の強度の変化に基づいて検出するようすれば良い。

【0161】また、同様の手法で図30に示す抜け終わり時間に基づいて、この抜け終わりを検出することで現像の終点とすることもできる。

【0162】この場合、前記モニタエリア701は、前記デバイスパターン111の現像終了時に膜厚がほとんど0となるように設計する。すなわち、60秒の現像した後に膜厚がほとんど0若しくは0となるような露光量が7.5mJであるレジストを用いる場合、デバイスパターン111の最適露光量が30mJであるので、デバイスパターン用露光マスクと比較して透過率が25%となるようにモニタエリア用の露光マスクを設計する。

【0163】前述したように、図30はモニタエリア701に対する膜抜け時間と露光量との関係を示すものである。

【0164】プロセス条件が常に一定であれば、現像時間は常に60秒で制御すればよいが、デバイスパターン111の露光量が適正值の30mJから29mJに変化した場合には、60秒では十分な現像が行なえないことになる。しかしながら、この実施形態では、モニタエリア701の膜抜け時点(膜厚0)を検出することで、このようなプロセス条件の変動にも対応でき、常に正確な終点制御を行なえる。

【0165】すなわち、デバイスパターン111の露光量が適正值の30mJから29mJに変化した場合、モニタエリア701の露光量はその25%であることから、モニタエリア701に対する露光量は7.25mJとなる。従ってこの場合、図30より、110秒後に膜抜けが終了する。したがって、この膜抜けを検出して現像の終点とすることで、プロセス条件の変動にも対応することができる。

【0166】(第14の実施形態) この実施形態は第9

の実施形態と同様の構成を有する寸法モニタ装置を用い、図32に示すように、各ホールの中心が成六角形の各頂点に位置するように配置してなるモニタバターン901をモニタする装置に関するものである。

【0167】このモニタバターン901は、他の実施形態のものと同様に、1ショット内においてデバイス作成に寄与するエリアと分離して $10 \times 10 \mu\text{m}^2$ のエリアに配置されている。

【0168】図33に、現像時間とモニタバターン901からの0次回折光の強度との関係を示す。この実施形態のモニタバターン901の場合、現像終点(60秒後)での強度変化は余り大きくならないため、現像終点の直接検出は困難である。このため、この実施形態では、現像初期の強度変化の大きい部分を0次回折光検出器で強度検出し、その検出値から現像終点を予測するようとする。予測方法としては、例えば、強度のしきい値を140に設定し、このしきい値を超えた後50秒後を現像の終点とする。

【0169】このような構成によれば、現像終点で強度変化の少ないバターンを用いた場合でも、比較的正確に現像の終点を検出することができる効果がある。

【0170】なお、本発明は上述した第1～第14の各実施形態に限定されるものではない。例えば、モニタバターンを構成する要素バターンの形状、繰り返しピッチ、繰り返し数等は、仕様に応じて適宜変更可能である。モニタバターンは、デバイスバターンに隣接してチップ有効部の空き領域に形成しても良いし、チップのダイシングライン等に形成しても良い。

【0171】モニタバターンに照射する光は実施形態に用いたものに何等限定されるものではなく、レジストを感光しない波長の単波長光(若しくは狭帯域の光)であればよい。現像後のバターン検査においては、レジストを感光させない波長である必要はない。モニタバターンからの回折光を検出する手段は、CCDカメラに限定されず、強度変化を検出できるものであればよい。

【0172】また、実施形態では、斜め照射で垂直方向に1次回折光の検出、又は垂直照射で垂直方向に0次回折光の検出を行ったが、斜め照射で斜め方向に0次回折光の検出、又は垂直照射で斜め方向に1次回折光の検出を行うようにしても良い。また、レジストに対する露光は必ずしも光に限らず、X線或いは電子ビームを用いることも可能である。

【0173】また、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができることはいうまでもない。

【0174】

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、現像中又は現像後に、デバイスバターンや既加工バターンとは異なるモニタバターン、特に現像時間の経過による回折光の強度変化が大きいモニタバターンを用いてバ

ターン評価を行うことにより、レジストバターンを短時間で高精度に検査することが可能となり、さらにこの検査を基に現像時間を制御することによって異なるウエハに対してもレジストバターンの精密な寸法制御が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態を説明するためのもので、1次回折光を利用して現像後のバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

10 【図2】第1の実施形態におけるモニタバターンの例を示す図。

【図3】第1の実施形態における現像時間と1次回折光強度の関係を示す図。

【図4】理想的なピッチとライン幅の比と1次回折光回折強度との関係を示す図。

【図5】第2の実施形態を説明するためのもので、1次回折光を利用して現像中にバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

20 【図6】第2の実施形態におけるデバイスバターンとモニタバターンの例を示す図。

【図7】バターンの繰り返しピッチと検出角との関係を示す図。

【図8】第3の実施形態におけるデバイスバターンとモニタバターンの例を示す図。

【図9】第4の実施形態におけるモニタバターンと既加工バターンの例を示す図。

30 【図10】第5の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図11】第5の実施形態におけるモニタバターンの例を示す図。

【図12】第5の実施形態における現像時間と0次回折光強度との関係を示す図。

【図13】第6の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図14】(a)～(c)は、第6の実施形態におけるモニタバターンの例を示す図。

40 【図15】(a)、(b)は、第6の実施形態におけるモニタヘッドの位置決めを示す図。

【図16】(a)～(c)は、第6の実施形態におけるモニタバターンの検出例を示す図。

【図17】第7の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図18】(a)、(b)は、第7の実施形態において、0次回折光の光路を説明するための図。

50 【図19】第8の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にバターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図20】第9の実施形態を説明するためのもので、この実施形態で用いるモニタエリアを示す概略図。

【図21】第9の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にパターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図22】第9の実施形態において、図20に示すモニタエリアからの0次回折光の強度とレジスト厚との関係を示す図。

【図23】第10の実施形態を説明するためのもので、0次回折光を利用して現像中にパターン検査を行う際の装置構成例を示す図。

【図24】第11の実施形態を説明するためのもので、図20に示すモニタエリアからの0次回折光の強度とレジスト厚との関係を示す図。

【図25】第11の実施形態を説明するためのもので、レジスト厚と現像時間との関係を示す図。

【図26】第12の実施形態を説明するためのもので、2つの異なる波長の光を用いて検出した場合の0次回折光の強度とレジスト厚との関係を示す図。

【図27】第12の実施形態の他の測定例を説明するためのもので、2つの異なる波長の光を用いて検出した場合の0次回折光の強度とレジスト厚との関係を示す図。

【図28】第12の実施形態の他の測定例を説明するた*

*めのもので、2つの異なる波長の光を用いて検出した場合のレジスト厚と現像時間との関係を示す図。

【図29】第13の実施形態を説明するためのもので、レジスト厚と現像時間との関係を示す図。

【図30】第13の実施形態を説明するためのもので、露光量とレジストの抜け時間との関係を示す図。

【図31】第13の実施形態を説明するためのもので、露光量とレジストの抜け始め時間との関係を示す図。

【図32】第14の実施形態で用いるモニタパターンの例を示す図。

【図33】第14の実施形態を説明するためのもので、0次回折光の強度と露光時間との関係を示す図。

【符号の説明】

100…ウェハ

110…レジスト

111…デバイスパターン

112…モニタパターン

201、301…入射光

202、302…0次回折光

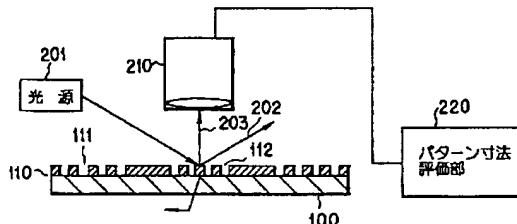
203、303…1次回折光

210…CCDカメラ

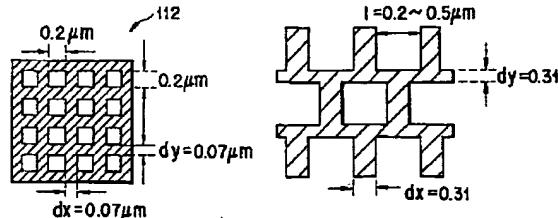
220…パターン寸法評価部

220'…現像終点予測部

【図1】

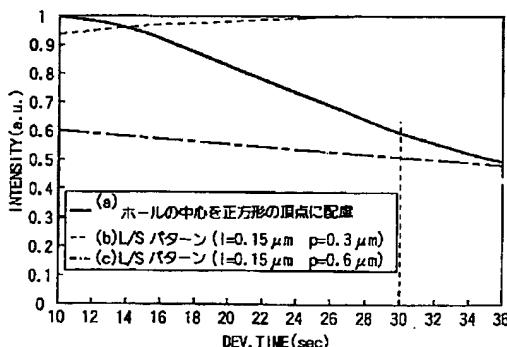


【図2】

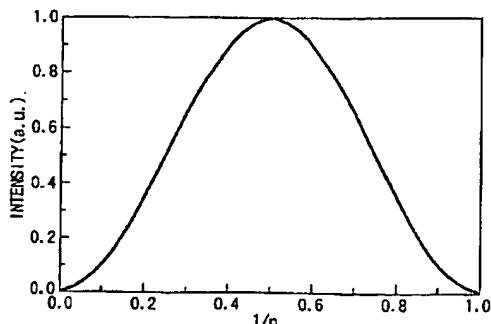


【図11】

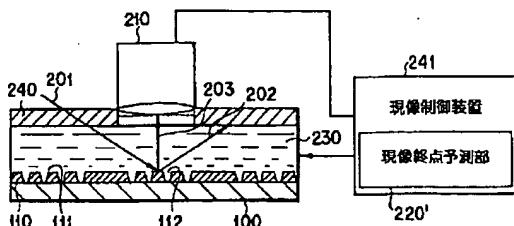
【図3】



【図4】

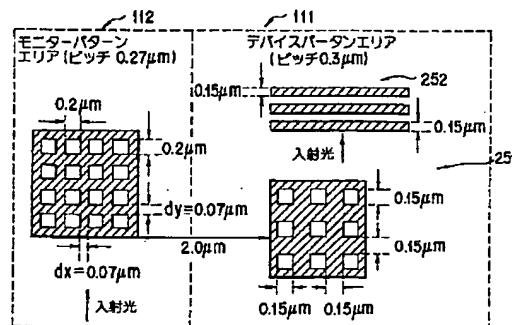


【図5】



[図7]

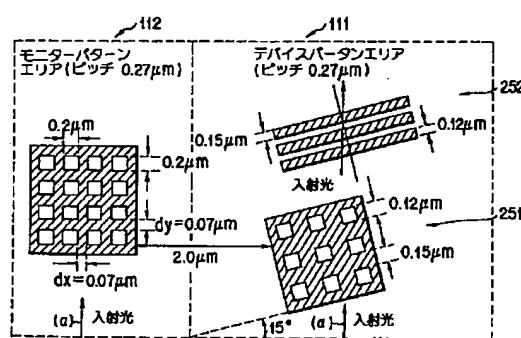
[図6]



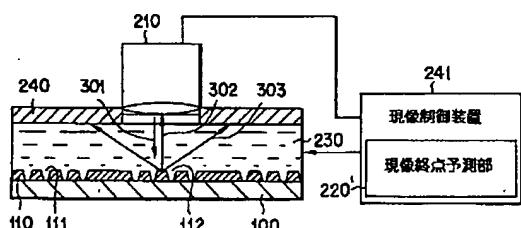
ピッチ (μm)	挿出角 (度)
0.25	70
0.27	55
0.30	40
0.33	30
0.36	22
0.40	15

[図9]

【图8】

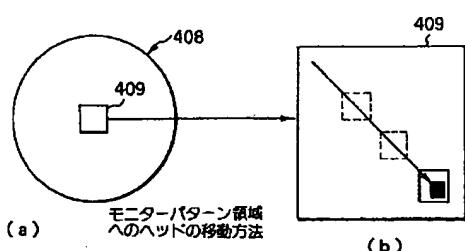


[図10]

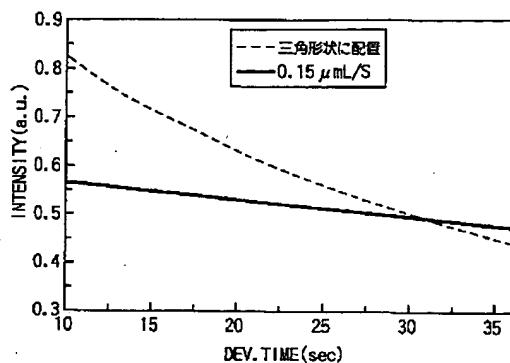


[図15]

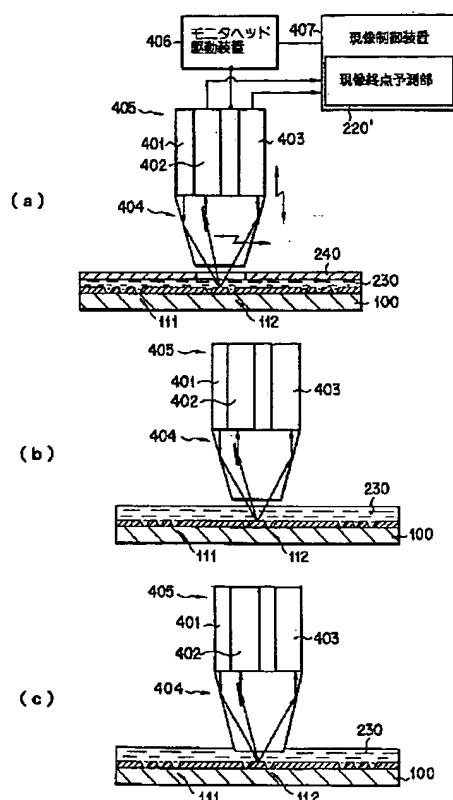
[図18]



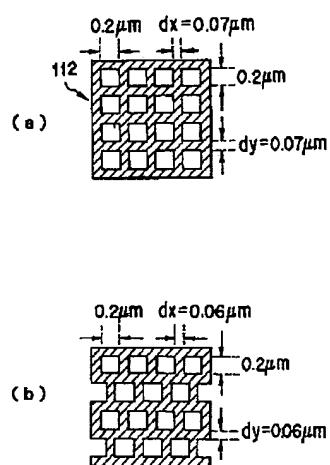
【図12】



【図13】

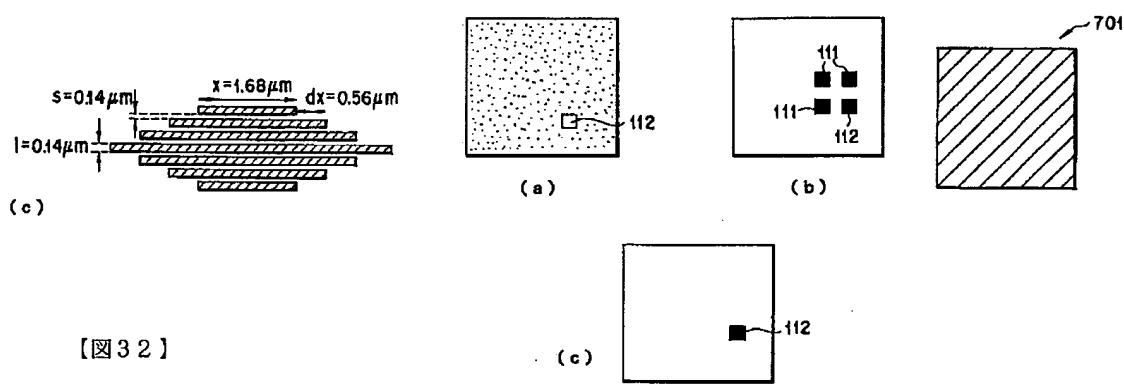


【図14】

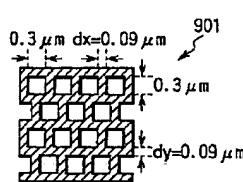


【図16】

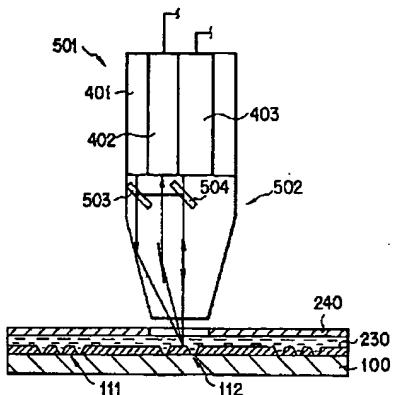
【図20】



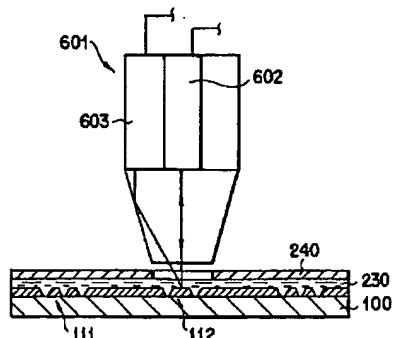
【図32】



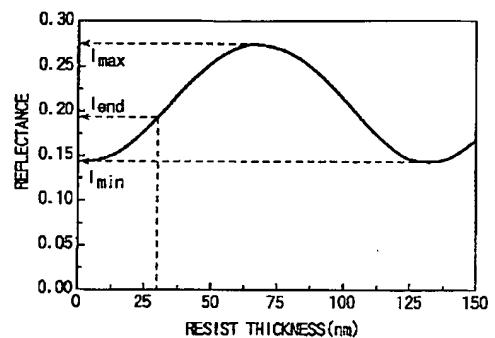
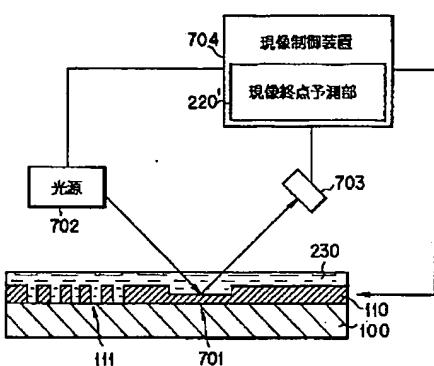
【図17】



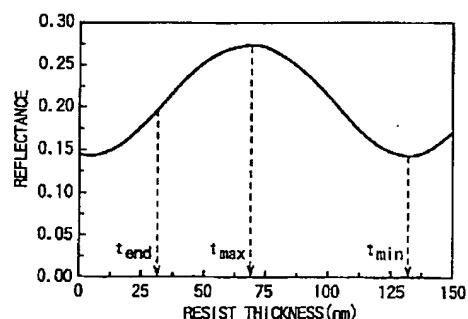
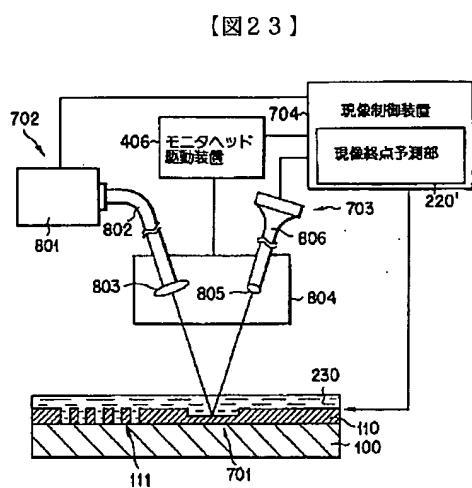
【図19】



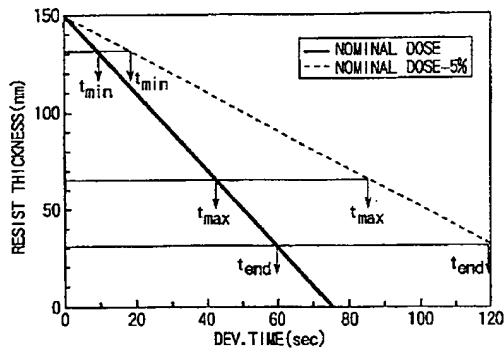
【図21】



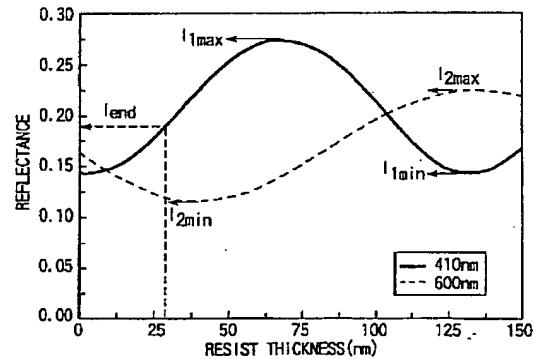
【図24】



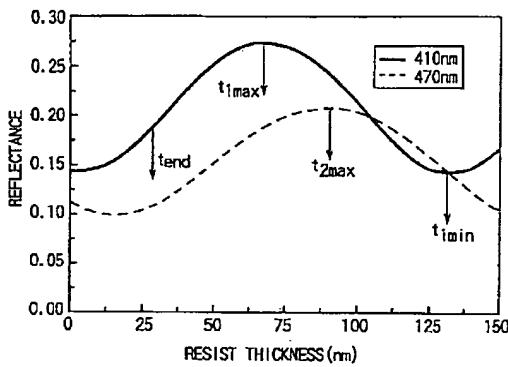
【図25】



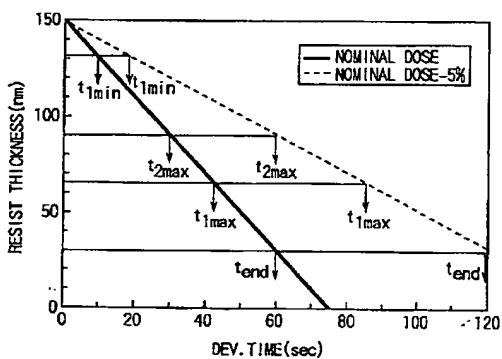
【図26】



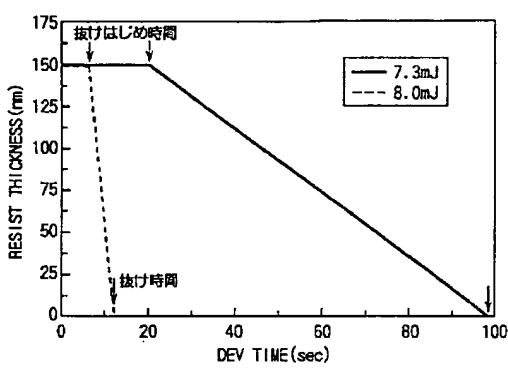
【図27】



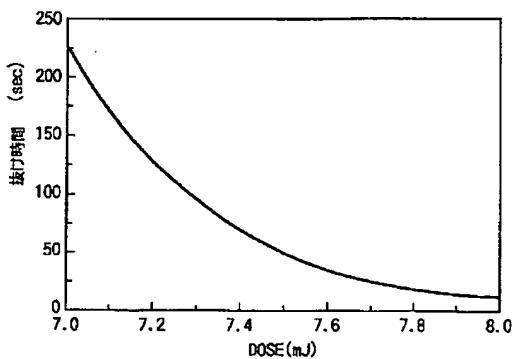
【図28】



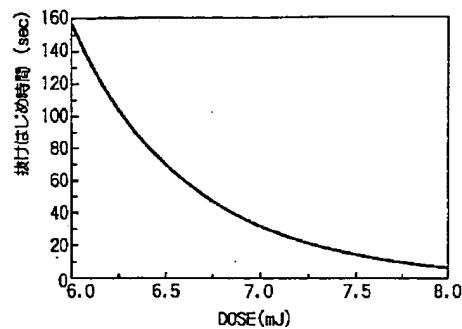
【図29】



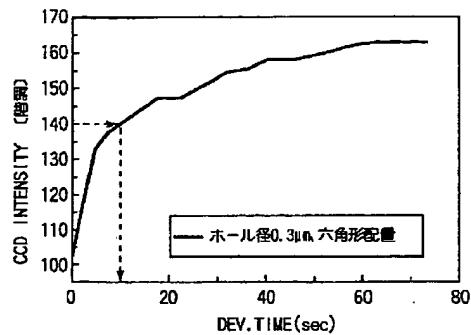
【図30】



【図31】



【図33】



フロントページの続き

(72)発明者 井上 壮一
神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者 奥村 勝弥
神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
式会社東芝横浜事業所内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年8月25日(2005.8.25)

【公開番号】特開平10-300428

【公開日】平成10年11月13日(1998.11.13)

【出願番号】特願平10-40603

【国際特許分類第7版】

G 01 B 11/02

G 03 F 7/26

H 01 L 21/027

【F I】

G 01 B 11/02 G

G 03 F 7/26 501

H 01 L 21/30 502 V

H 01 L 21/30 502 G

【手続補正書】

【提出日】平成17年2月10日(2005.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被処理体上の、デバイスパターンと異なる位置に形成されたモニタ領域に対し、特定波長の平行光を照射するための照明手段と、前記モニタ領域からの回折光強度を検出する手段と、このモニタ領域からの回折光強度に基づいて前記デバイスパターン寸法を評価するデバイスパターン評価手段とを有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項2】

請求項1のパターン寸法評価装置において、前記被処理体のモニタ領域には、モニタパターンが設けられており、このモニタパターンは、デバイスパターンとは異なる要素パターンで構成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項3】

請求項2記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタパターンは、前記デバイスパターンと異なるピッチで形成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項4】

請求項2記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタパターンは、パターンの周期性の方向が、前記デバイスパターンと異なるように形成され、このモニタパターンからの回折光をデバイスパターンからの回折光と分離して検出できるように構成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項5】

請求項2記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタパターンは、露光用パターン要素の間隔が解像限界以下となるように隣接して周期的に配置してなる露光パターンを通してレジストを露光することで形成されたものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 6】

請求項 1 記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタ領域は、全体に亘って略均一の現像速度となるように露光され、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるよう形成されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 7】

請求項 6 記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタ領域は、デバイスパターンを作成したマスクと同一面内に作成したマスクパターンを用いてデバイスパターンと同一条件で露光することにより作成するものであって、モニタ領域形成用のマスクパターンは、露光条件に対して被処理体上に0次回折光しか到達しないピッチを有する規則パターンであり、かつ、現像の進行に伴い徐々にかつ略均一に膜減りが生じるような透過率となるようにマスクパターンの抜きと残しの比率が設計されたものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 8】

請求項 1 記載のパターン寸法評価装置において、前記デバイスパターン評価手段は、前記モニタ領域からの0次回折光若しくは1次回折光の光強度に基づいてデバイスパターン寸法を評価するものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 9】

請求項 8 記載のパターン寸法評価装置において、前記照明手段は、照明光をモニタ領域に対して垂直に照射する手段を有し、前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる0次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 10】

請求項 8 記載のパターン寸法評価装置において、前記照明手段は、照明光をモニタ領域に対して斜め方向から照射する手段を有し、前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる1次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 11】

請求項 8 記載のパターン寸法評価装置において、前記照明手段は、0次回折光検出手用の照明光をモニタ領域に対して垂直に照射する手段と、1次回折光検出手用の照明光をモニタ領域に対して斜め方向から照射する手段とを有し、前記回折光強度検出手段は、前記モニタ領域から略垂直に得られる0次回折光及び1次回折光を検出する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 12】

請求項 8 記載のパターン寸法評価装置において、モニタ領域からの1次回折光の検出結果とモニタ領域・デバイスパターンからの0次回折光の検出結果との論理積から、モニタ領域の位置を検出するモニタ領域検出手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 13】

請求項 1 記載の装置において、前記照明手段と回折光の検出手段とを保持するモニタヘッドと前記回折光の検出手段による検出に基づいてモニタ領域を検知する手段とを有し、検知したモニタ領域に対し、このモニタヘッドを駆動・位置決めするモニタヘッド位置決め手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 14】

請求項 1 のパターン寸法評価装置において、この装置は、デバイスパターンの現像終点を検出するのに適用されるものであって、前記パターン寸法評価手段は、モニタ領域からの回折光の強度変化に基づいて現像の終点を判断する手段を有することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 15】

請求項 14 記載のパターン寸法評価装置において、前記現像の終点を判断する手段は、回折光強度の時間微分値を求め、予め求められている現像時間と回折光強度の時間微分値

との関係と照合することにより、現像の終点を検出するものであることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 16】

請求項 14 のパターン寸法評価装置において、照明手段からモニタ領域に照射される照明光として、モニタ領域の膜減りに伴う回折光の強度変化が極大・極小を有する波長の光を用い、現像の終点を予測する手段は、検出された回折光強度変化の極大・極小に基づいて現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 17】

請求項 14 のパターン寸法評価装置において、照明手段からモニタ領域に照射される照明光として、モニタ領域の膜減りに伴う回折光の強度変化の時間微分値が極大・極小を有する波長の光を用い、現像の終点を予測する手段は、検出された回折光強度変化の時間微分値の極大・極小に基づいて現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 18】

請求項 14 のパターン寸法評価装置において、照明手段からモニタ領域に照射される照明光として 2 以上の異なる波長の光を用いることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 19】

請求項 14 記載のパターン寸法評価装置において、前記モニタ領域は、デバイスパターンに対する現像終点に基づいて決定されたタイミングで所定の膜厚となるように露光されており、前記現像の終点を予測する手段は、前記モニタ領域が前記所定の膜厚となる回折光の強度を検出することで現像終点を予測することを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 20】

請求項 14 のパターン寸法評価装置において、前記現像の終点を予測する手段は、前記デバイスパターンからの回折光の強度が所定の値を超えたことにに基づいて現像終点を予測するものであって、前記現像終点を予測するために検出する所定の値は、現像開始直後の回折光の強度変化の大きい範囲に設定されていることを特徴とするパターン寸法評価装置。

【請求項 21】

被処理基板上のレジスト膜を露光し、前記レジスト膜を現像することによってデバイスパターン及びモニタパターンを形成し、デバイスパターンの寸法をモニタパターンに基づいて評価する、パターン寸法評価方法であって、

モニタマスクパターンを設計するステップであって、前記モニタマスクパターンはデバイスパターンの素子のピッチより小さいピッチで並列配置された前記モニタパターンを前記レジスト膜に形成するように構成され、前記現像の終点における前記モニタパターンからの反射光強度の変化が、前記デバイスパターンからの反射光強度の変化よりも大きくなるように前記モニタマスクパターンが構成されているステップと、

デバイスマスクパターンと設計された前記モニタマスクパターンとを具備するマスクを用いて前記レジスト膜を 1 ショットで露光するステップと、

露光されたレジスト膜を現像することによって、前記デバイスパターン及びモニタパターンを形成するステップと、

現像後、所定の波長の平行光を前記モニタパターンに照射するステップと、

前記モニタパターンからの回折光強度を検出するステップと、

前記デバイスパターンを形成するための照射量と略同一の照射量で形成されたモニタパターンからの回折光強度に基づいて前記デバイスパターンの寸法を評価するステップとを含むパターン寸法評価方法。

【請求項 22】

前記モニタパターンからの回折光と前記デバイスパターンからの回折光と分離して検出できるようにするために、前記モニタパターンのピッチは前記デバイスパターンのピッチとは異なることを特徴とする請求項 21 に記載のパターン寸法評価方法。

【請求項 23】

前記モニタパターンからの回折光とデバイスパターンからの回折光とを分離して検出できるようにするために、前記モニタパターンの周期的なパターンの配列方向がデバイスパターンの配列方向と異なることを特徴とする請求項 21 に記載のパターン寸法評価方法。

【請求項 24】

前記モニタパターンからの0次回折光または1次回折光の回折光強度に基づいてデバイスパターンの寸法の評価が行われることを特徴とする請求項 21 に記載のパターン寸法評価方法。

【請求項 25】

被処理基板上のレジスト膜を露光し、前記レジスト膜を現像することによってデバイスパターン及びモニタ領域を形成し、前記デバイスパターンの寸法をモニタ領域に基づいて評価する、パターン寸法評価方法であって、

現像の進行に伴い、徐々に膜減りが生じるような前記モニタ領域をレジスト膜に形成するようなモニタマスクパターンを設計するステップと、

前記デバイスマスクパターンと設計された前記モニタマスクパターンとを具備するマスクを用いて前記レジスト膜を1ショットで露光するステップと、

露光されたレジスト膜を現像することによって、前記レジスト膜にデバイスパターン及びモニタ領域を形成するステップと、

現像後、所定の波長の平行光をモニタ領域に照射するステップと、

前記モニタ領域からの回折光強度を検出するステップと、

デバイスパターンを形成するための照射量と略同一の照射量で形成されたモニタ領域からの回折光強度に基づいて前記デバイスパターンの寸法を評価するステップとを含むパターン寸法評価方法。

【請求項 26】

デバイスパターンの寸法評価は、前記モニタ領域からの0次回折光強度に基づいて行われることを特徴とする請求項 25 に記載のパターン寸法評価方法。

【請求項 27】

被処理基板上のレジスト膜を露光し、前記レジスト膜を現像することによってデバイスパターンを形成する、パターン形成方法であって、

モニタマスクパターンを設計するステップであって、前記モニタマスクパターンはデバイスパターンの素子のピッチより小さいピッチで並列配置された前記モニタパターンを前記レジスト膜に形成するように構成され、前記現像の終点における前記モニタパターンからの反射光強度の変化が、前記デバイスパターンからの反射光強度の変化よりも大きくなるように前記モニタマスクパターンが構成されているステップと、

デバイスマスクパターンと設計された前記モニタマスクパターンとを具備するマスクを用いて前記レジスト膜を1ショットで露光するステップと、

露光されたレジスト膜を現像するステップと、

現像中、所定の波長の平行光をモニタパターンに照射するステップと、

前記現像中のモニタパターンからの回折光強度を検出するステップと、

デバイスパターンを形成するための照射量と略同一の照射量で形成されたモニタパターンからの回折光強度に基づいて前記デバイスパターンの寸法を評価するステップと、

前記デバイスパターンの寸法評価の結果に基づいてデバイスパターンの現像時間を制御するステップとを含むパターン形成方法。

【請求項 28】

被処理基板上のレジスト膜を露光し、前記レジスト膜を現像することによってデバイスパターンを形成する、パターン形成方法であって、

現像の進行に伴い、徐々に膜減りが生じるようモニタ領域をレジスト膜に形成するようなモニタマスクパターンを設計するステップと、

デバイスマスクパターンと設計された前記モニタマスクパターンとを具備するマスクを用いて前記レジスト膜を1ショットで露光するステップと、

露光されたレジスト膜を現像することによって、レジストのデバイスパターン及びモニタ領域を形成するステップと、
前記現像中に所定の波長の平行光をモニタ領域に照射するステップと、
前記現像中のモニタ領域からの回折光強度を検出するステップと、
デバイスパターンを形成するための照射量と略同一の照射量で形成されたモニタ領域からの回折光強度に基づいて前記デバイスパターンの寸法を評価するステップと、
前記デバイスパターンの寸法評価の結果に基づいてデバイスパターンの現像時間を制御するステップとを含むパターン形成方法。

【請求項 29】

前記モニタパターンを形成するために用いられるマスクは、以下の式によって定まる条件を満たすピッチ p のモニタパターンを有する、
$$\lambda / p \geq (1 + \sigma) \text{ NA},$$

ここで、 λ は露光波長、 σ はコヒーレントファクタ、NA は 0 次回折光だけが基板上に到達することができる開口数であることを特徴とする請求項 25 または請求項 28 に記載のパターン形成方法。

【請求項 30】

前記モニタパターンを照明する平行光は、少なくとも二つの波長を有することを特徴とする請求項 27 または請求項 28 に記載のパターン形成方法。

【請求項 31】

前記モニタパターンを照明する平行光はモニタパターン領域のレジスト膜の膜減りに伴って変化する回折光強度が極大値及び極小値を有する波長を有し、

現像の終了時間を検出するために、前記回折光の極大値及び極小値に基づいて前記デバイスパターンの寸法評価を行うことを特徴とする請求項 28 に記載のパターン形成方法。